

國立政治大學 函

機關地址：臺北市文山區指南路二段64號
聯絡人：陳瑞英
聯絡電話：02-29393091#66899

受文者：如行文單位

發文日期：中華民國110年11月26日

發文字號：政研發字第1100035629號

速別：最速件

密等及解密條件或保密期限：

附件：科技部函、計畫徵求公告、國際合作經費編列範例

主旨：科技部公開徵求111年度「次世代化合物半導體前瞻研發專案計畫」，校內截止收件時間為111年1月21日（五）下午5時止，逾期不予受理，請查照轉知。

說明：

一、依科技部110年11月25日科部工字第1100070313號函辦理。

二、本專案目標為因應在電源、混合動力與電動車、B5G/6G高頻元件/系統等應用，將以國內矽基半導體和光電產業為基礎，擴展次世代化合物半導體領域。研究項目分成兩個分項，內容如下：

(一) B5G/6G 高頻通訊關鍵半導體技術專注於氮化鎵(GaN)、磷化銦(InP)於超高速的元件技術開發。

(二) 下世代寬能隙高壓功率半導體技術：專注於氮化鎵(GaN)、碳化矽(SiC)、氧化鎵(Ga₂O₃)及鑽石(Diamond)等寬能隙材料。

三、申請注意事項：

(一) 應規劃四年(111年5月1日至115年4月30日止)，業經審查通過，核定補助二年(111年5月1日至113年4月30日止)，採分年核定多年期計畫。

(二) 以單一整合型計畫為限，每一整合型計畫之總計畫及

所有子計畫全部書寫於一份計畫書，子計畫應為三個(含)以上，最多以不超過六個為原則。總計畫主持人須同時主持1項子計畫，各主持人應實質參與研究，計畫書應詳實註明各主持人負責之研究主題，整合之計畫需有整體明確的目標，並由總計畫主持人之服務機關提出申請。

(三) 申請書表格採用一般專題研究計畫之計畫書格式，其中表CM03研究計畫內容頁數以不超過60頁為限。

(四) 有意申請者，請於旨揭截止日期前於「專題類-隨到隨審計畫」，計畫類別點選「一般策略專案計畫」；研究型別請點選「整合型」；計畫歸屬請勾選「工程司」；學門代碼請勾選「E9870-次世代化合物半導體前瞻研發計畫」。完成線上申請作業，並請所屬單位於次日中午前將申請名冊（經單位主管核章）送達研發處，俾利備函彙送科技部提出申請。

四、本計畫之徵求重點及相關申請須知等注意事項，請詳閱科技部工程司網站（<https://www.most.gov.tw/eng/ch>）-公告事項參閱。

五、計畫申請如有疑義，請洽科技部黃士育副研究員，電話：02-2737-7374。有關系統操作問題，請洽科技部資訊處，電話：0800-212-058、02-2737-7590~2737-7592。

正本：本校各院、系、所、研究中心(電子布告欄)

副本：研究發展處

校長 郭明政